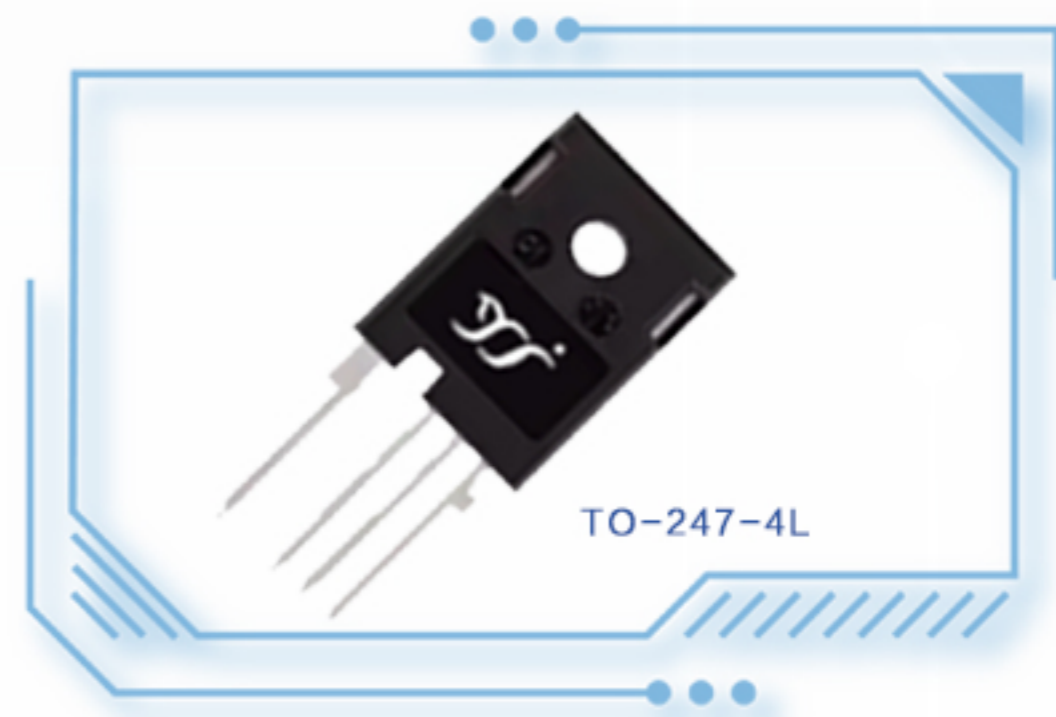
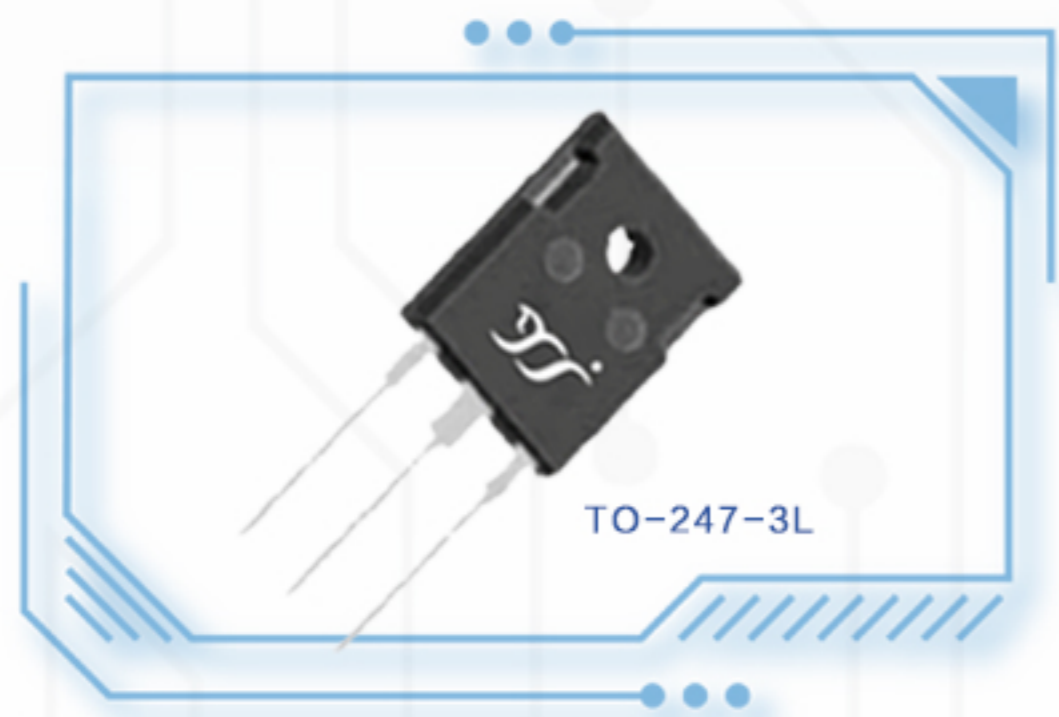


## 1200V 80mΩ SiC MOSFET

### 产品介绍

- 1.近年来PV逆变器市场进入高速发展期，对碳化硅功率器件的需求迅速增大，碳化硅二极管和MOSFET应用于BOOST电路中时，可以提高系统的开关速度，从而可以优化整个系统的能耗和体积；
- 2.碳化硅 MOSFET为匹配PV行业客户需求，开关性能、通流能力以及产品可靠性可以对标行业最佳；
- 3.不仅适用于常规开关应用，还满足控制要求高的高压高速开关应用，采用环保物料，符合RoHS标准；



### 产品特点

- 1.耐高温特性，工作温度（175° C）；单极性器件,开关速度快，损耗低，适用于高压，高频的应用条件；
- 2.采用先进的减薄工艺，使SiC MOSFET具有优异的低阻抗特性，减小器件能量损耗；
- 3.产品封装类型有TO-247-3L，TO-247-4L等多种封装形式可选；
- 4.通过行业严苛的可靠性认证，包括大批量的HTRB、HTGB测试和HV-H3TRB测试。

### 电性参数

Product	Blocking Voltage	Current Rating	Generation	Rdson(mΩ) @25°C	Gate Charge Total Qg (nC)	Output Capacitance Coss (pF)	Total Power Dissipation P <sub>TOT</sub> (W)	Thermal resistance RthJ-C(°C/W)	Maximum Junction Temperature (°C)	Package
YJD212080NCTG1	1200V	38A	Gen1	77	41	58	220	0.68	175	TO247-3L
YJD212080NCFG1	1200V	39A	Gen1	77	41	58	223	0.67	175	TO247-4L

更多产品详见官网

### 应用领域



光伏逆变器



充电桩



EV应用



电源